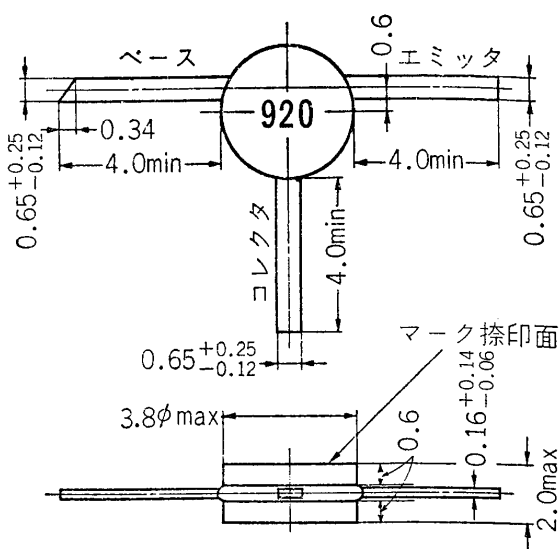


2SC920

NPNエピタキシャルプレーナ形シリコントランジスタ
 マイクロディスク
 高周波増幅および周波数変換用

- 小形ラジオの高周波増幅，周波数変換，混合発振，FM IF増幅用として最適。
- 雑音指数が小さい。
 NF : 25dB (1 MHz) 標準
- 外形が小さいので機器の小形化が可能。
- 自動生産ラインの採用により特性が均一。

外形図 (単位: mm)



絶対最大定格 (T_a = 25°C)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	25	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	5.0	V
コレクタ電流	I _C	30	mA
コレクタ損失	P _C	150	mW
ジャンクション温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-65 ~ +150	°C

電氣的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	最小	標準	最大	単位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=15\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=3.0\text{V}, I_C=0$			0.1	μA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=3.0\text{V}, I_C=0.5\text{mA}$	30	75		
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1.0\text{mA}$			0.6	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}$	150	250		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=6.0\text{V}, I_E=0,$ $f=1.0\text{MHz}$		1.6	2.5	pF
$C_c \cdot r_{bb'}$ 積	$C_c \cdot r_{bb'}$	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-1.0\text{mA}$ $f=31.9\text{MHz}$			50	ps
雑音指数	NF	$V_{CE}=6.0\text{V}, I_E=-0.5\text{mA}$ $f=1.0\text{MHz}, R_g=500\Omega$		2.5	3.5	dB

本製品は開発品種ですので、後日規格を変更する場合があります。